

## 产品特性 FEATURES

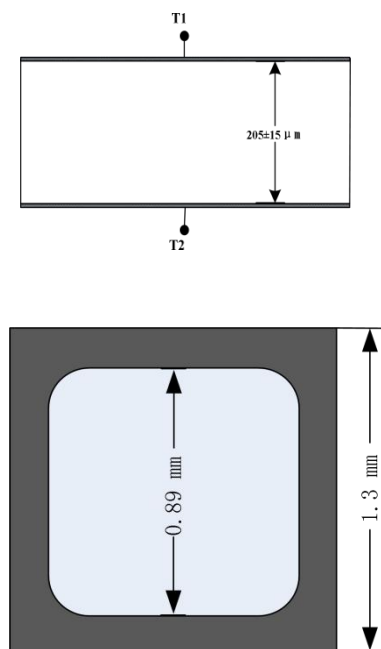
芯片特征：NPNPN 五层结构的硅双向器件，过电压触发导通，电压一致性好，高可靠性，三层金属电极。

## 芯片电特性CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>c</sub>=25°C)

参数 Parameter	测试条件 Test Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V <sub>RM</sub>	I <sub>RM</sub> =1μA	25			V
最高限制电压 V <sub>BO</sub>	1KV/μs			40	V
通态电压 V <sub>TM</sub>	I <sub>T</sub> =2.2A			4	V
维持电流 I <sub>H</sub>	10A, 10/1000μs	40		150	mA
极间电容 C	2V, 1MHz			40	pF
转折电流 I <sub>S</sub>				800	mA
脉冲突波测试 Surge pulse current	10/1000μs ± 5 Times				A
	2/10μs ± 1 Times				A
	8/20μs ± 1 Times				A
	10/700μs	2500			V
结温	T <sub>j</sub>	-55		125	°C

## 芯片信息确认CHIP INFORMATION CONFIRM

芯片工艺 Wafer technique	平面	
圆片尺寸 Wafer Size	<input checked="" type="checkbox"/> Φ4inch <input type="checkbox"/> Φ3inch <input type="checkbox"/> 其它 Other _____	
芯片厚度 Chip Thickness	(205±15) μm	
芯片尺寸 Chip Size	1.3mm×1.3mm	
有效图形数 Effective number	4310 dies/wafer	
金属 Metal	正面 Front	Ti+Ni+Ag
	背面 Back	Ti+Ni+Ag
键合区面积 Bond Area	<b>890μm *890μm</b>	



### NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.